

碳化硅 (SiC) 晶片

产品名称	碳化硅 (SiC) 晶片
公司名称	厦门中芯晶研半导体有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市湖里高新技术园区岭下南路77号
联系电话	0592-5633652 15306096621

产品详情

厦门中芯晶研可提供2",3",4",6"碳化硅单晶片。

碳化硅晶片由纯硅和碳组成，与硅相比具有三大优势:

- | 更高的临界雪崩击穿场强
- | 更大的导热系数
- | 更宽的禁带

碳化硅晶片具有3电子伏特(eV)的宽禁带，可以承受比硅大8倍的电压梯度而不会发生雪崩击穿。禁带越宽，在高温下的漏电流就越小，效率也越高。而导热系数越大，电流密度就越高。SiC衬底具有更高的电场强度，因而可以使用更薄的基础结构，其厚度可能仅为硅外延层的十分之一。此外，SiC的掺杂浓度比硅高2倍，因此器件的表面电阻降低了，传导损耗也显著减少。